

半 导 体 学 报

第 9 卷 第 2 期

1988 年 3 月

目 录

- 用激光延迟法研究 DH 激光器的复合性质..... 张存善 谢京涛 (113)
- 带衬底偏置的 MOSFET CAD 模型.....孙兴初 (120)
- 石墨炉原子吸收法测定硅中铂族金属掺杂剂.....崔仙航 马会民 (129)
- 质量迁移层对 InGaAsP BH 半导体激光器阈值电流和模式行为的影响
.....郭长志 陈水莲 (135)
- 用固溶强化模型计算 InP 中等价电子杂质对位错的钉扎力...叶式中 杨保华 (150)
- 聚合物半导体 P3MT/溶液界面的光电特性及 P3MT 表面铂原子的光电催化
作用...袁仁宽 黄振春 D. Peramunage, M. Tomkiewicz, D. S. Ginley (156)
- 硅的等离子体形成及相变微微秒时间分辨的探测...马海明 刘一先 李富铭 (163)
- 双吸除技术在 CCD 制造中的应用及其具有增强吸除功能的研究.....
.....周士仁 叶以正 叶水驰 麦振洪 戴道扬 杨家德 陈慕章 (169)
- 硅片抛光工艺质量微细差别的椭圆光谱法鉴别.....陈 哉 钱佑华 (175)
- 非晶半导体超晶格紫外-可见-红外光谱的研究.....
.....毛国民 陈坤基 杜家方 李志锋 陈 泓 (181)
- 零偏源 MOS 结构的栅电荷弛豫机制及近少子带界面态分布的瞬态谱测定
.....郑心奋 李志坚 (189)
- 二向不等距网格上的通道区布线及其实体化.....庄文君 高春华 (200)

研 究 简 报

- H、F、Cl/Si(111) 化学吸附的半经验 CNDO 法研究..... 吴汲安 (205)
- 高阻硅低温欧姆接触.....李 刚 沈复初 姚奎鸿 阙端麟 (208)
- 多量子阱结构不均匀性的 TEM 观察.....范缙文 (211)
- 分子束外延高质量 GaAs-AlGaAs 量子阱结构
.....梁基本 孔梅影 孙殿照 曾一平 黄运衡 (213)

研 究 快 报

- 异质结 NIPI 结构的光调制反射光谱.....汤寅生 江德生 (217)
- 二氧化硅的表面改性.....韩阶平 王培大 徐卫东 金钟元 陈梦真 (221)

会 议 简 讯

- 第六届全国半导体物理学术会议在广州召开..... (224)